



دانشگاه شهرستان و بلوچستان

تحصیلات تکمیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته نانو فیزیک

عنوان:

سنتر و مشخصه‌یابی نانوذرات کپالت اکسید

استاد راهنما:

دکتر موسی علی‌احمد

استاد مشاور:

دکتر حمیده سراوانی

تحقیق و نگارش:

مریم مولاپناه کنارویی

(این پایان نامه از حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان بهره مند شده است)

۱۳۸۹ بهمن

بسمه تعالی

این پایان نامه با عنوان سنتز و مشخصه‌یابی نانوذرات کپالت اکسید قسمتی از برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد فیزیک توسط دانشجو مریم مولاپناه کنارویی تحت راهنمایی استاد پایان نامه دکتر موسی علی‌احمد تهیه شده است. استفاده از مطالب آن به منظور اهداف آموزشی با ذکر مرجع و اطلاع کتبی به حوزه تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان مجاز می‌باشد.

مریم مولاپناه کنارویی
امضا

بسمه تعالی

این پایان نامه با عنوان سنتز و مشخصه یابی نانوذرات اکسید کربالت قسمتی از برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد نانوفیزیک توسط دانشجو مریم مولاناه کنارویی با راهنمایی استاد پایان نامه آقای دکتر موسی علی احمد تهیه شده است. استفاده از مطالب آن به منظور اهداف آموزشی با ذکر مرجع و اطلاع کتبی به حوزه تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان مجاز می باشد.

مریم مولاناه کنارویی
امضاء

این پایان نامه ۴۰ واحد درسی شناخته می شود و در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۷ توسط هیئت داوران بررسی و درجه ۶۰ به آن تعلق گرفت.

تاریخ

امضاء

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما:

آقای دکتر موسی علی احمد

استاد راهنما:

خانم دکتر حمیده سراوانی

استاد مشاور:

آقای دکتر مصطفی حبیبی خراسانی

داور ۱:

آقای دکتر احمد رضا دارائی

داور ۲:

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر علیرضا آقایی



دانشگاه سیستان و بلوچستان

تعهدنامه اصالت اثر

اینجانب مریم مولاپناه کنارویی تأیید می کنم که مطالب مندرج در این پایان نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این نوشته از آن استفاده شده است مطابق مقررات ارجاع گردیده است. این پایان نامه پیش از این برای احراز هیچ مدرک هم سطح یا بالاتر ارائه نشده است. کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد.

نام و نام خانوادگی دانشجو: مریم مولاپناه کنارویی

امضاء

تقدیم به:

برترین معلمان هر زندگی

پدر و مادر

سپاسگزاری

شاکرم آن خدایی را که هر چه هست و نیست از اوست.

از راهنمایی‌های دکتر علی‌احمد، دکتر سراوانی و همکاری صمیمانه مهندس سرگزی و دانشگاه پیام نور زاهدان و همچنین سرکار خانم حشمت‌نژاد و دوستان بسیار عزیزم نرگس نصیری مقدم، زهرا شاهدی و سیما شکرخوش در انجام این پایان نامه کمال تشکر و سپاس را دارم.

چکیده:

در این پایان نامه تهیه نانوذرات کبالت اکسید به دو روش متفاوت سل-ژل و واکنش حالت جامد بررسی می شود. اندازه گیری های UV-Vis ، TEM ، FT-IR و VSM به ترتیب مشخصات ساختاری، طیفنمايی، مورفولوژی، مغناطیسی و نوری نمونه های تولیدی را نشان می دهد. طیف XRD تشکیل نانوذرات Co_3O_4 با ساختار اسپینل را نشان می دهد. با کمک فرمول شرر اندازه میانگین نانو ذرات حاصل از سل-ژل ۲۵ nm و واکنش حالت جامد، ۵۴ nm تخمین زده می شود. طیف FT-IR تشکیل پیوند های مربوط به کبالت اکسید را تایید می کند. با استفاده از تصویر TEM مشخص می شود که اندازه و شکل نانوذرات در نمونه سل - ژل و حالت جامد به ترتیب، ۱۴ nm شبکه کروی و ۶۳ nm مکعب مستطیل شکل هستند. با توجه به نمودار VSM، نمونه های تولیدی در دمای اتاق رفتار پارامغناطیسی از خود نشان می دهند. از طیف-UV مشاهده می شود که گاف انرژی نمونه ها در مقایسه با حالت توده ای، مقادیر بزرگتری را دارا می باشند. پس از تهیه نانو ذرات کبالت اکسید، از آن ها جهت ایجاد سطح ابرآب گریز استفاده می شود. نانوذرات تولیدی روی زیر لایه شیشه ای پوشش داده شده و سپس در کوره قرار می گیرند. در نهایت از استئاریک اسید جهت اصلاح سطح استفاده می شود. زاویه تماس قطرات آب روی سطح ابرآب گریز تهیه شده از نانوذرات تولیدی به روش واکنش حالت جامد $152/55^{\circ}$ و زاویه شیب $6/0^{\circ}$ ، می باشد در حالیکه این مقادیر برای سطح تهیه شده از نانو ذرات تولیدی به روش SEM تاثیر میکرو و نانو ساختارها را در ایجاد خاصیت ابرآب گریزی سطوح تایید می کند.

کلمات کلیدی: کبالت اکسید - سل-ژل - زاویه شیب - زاویه تماس - ابرآب گریز

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	فصل اول : مقدمه
۲	۱-۱- نانو تکنولوژی چیست؟
۳	۲-۱- مروری بر نانو مواد
۳	۱-۲-۱- ساختار نانو ذرات
۴	۲-۲- خواص نانو ذرات
۵	۱-۲-۲-۱- خواص نوری
۶	۲-۲-۲-۱- خواص مغناطیسی
۱۰	۳-۱- نانوذرات کجالت اکسید
۱۱	۴-۱- سطوح ابر آب گریز
۱۳	۱-۴-۱- حالت های مختلف تر شوندگی سطوح
۱۷	۲-۴-۱- روش های ساخت سطوح ابر آب گریز
۲۰	۳-۴-۱- کاربرد سطوح ابر آب گریز
۲۲	فصل دوم : مروری بر روش های سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات
۲۳	۱-۲- روش های تولید نانو ذرات
۲۳	۱-۱-۲- روش سل - ژل
۲۶	۲-۱-۲- روش واکنش حالت جامد
۲۸	۲-۲- ابزار تحلیل نانو ذرات
۲۸	۱-۲-۲- میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM
۳۰	۲-۲-۲- میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
۳۲	۳-۲-۲- پراش اشعه ایکس XRD
۳۴	۴-۲-۲- مغناطیس سنج VSM
۳۵	۵-۲-۲- طیفسنج نوری UV-Vis
۳۶	۶-۲-۲- طیفسنجی مادون قرمزانقلال فوریه FT-IR

فصل سوم : کارهای آزمایشی انجام شده

- ۴۰ ۱-۳ - تهیه نانوذرات کبالت اکسید به روش سل - ژل
۴۱ ۲-۳ - تهیه نانو ذرات کبالت اکسید به روش واکنش حالت جامد
۴۳ ۳-۳ - تهیه لایه‌های ابر آب گریز
۴۴ ۴-۳ - تجهیزات به کار رفته جهت بررسی نمونه‌ها

فصل چهارم : ارائه نتایج و تحلیل یافته‌ها

- ۴۸ ۱-۴ - واکنش‌های شیمیایی انجام شده
۴۹ ۲-۴ - تحلیل نتایج طیف XRD
۵۴ ۳-۴ - تحلیل نتایج UV-Vis
۵۸ ۴-۴ - تحلیل نتایج VSM
۶۰ ۵-۴ - تحلیل نتایج طیف FT-IR
۶۱ ۶-۴ - تحلیل تصاویر TEM
۶۲ ۷-۴ - تحلیل تصاویر SEM از سطوح تولیدی
۶۷ ۸-۴ - بررسی خواص آب گریزی سطوح تولیدی

فصل پنجم : جمع‌بندی و پیشنهادات

- ۷۲ ۱-۵ - جمع‌بندی
۷۳ ۲-۵ - پیشنهادات

۷۴ مراجع

فهرست جدول ها

عنوان جدول	صفحة
جدول ۱-۱ . توصیف دسته های مختلف مواد از نظر مغناطیسی	۸
جدول ۱-۳ . مواد شیمیایی مورد استفاده در تهیه نانوذرات کبالت اکسید به روش سل - ژل	۴۱
جدول ۲-۳ . مواد شیمیایی مورد استفاده در تهیه نانوذرات کبالت اکسید به روش واکنش حالت جامد	۴۴
جدول ۱-۴ . مقادیر استخراج شده از طیف XRD برای نمونه شماره ۱	۵۰
جدول ۲-۴ . مقادیر استخراج شده از طیف XRD برای نمونه شماره ۲	۵۱
جدول ۳-۴ . مقادیر استخراج شده از طیف XRD برای نمونه شماره ۳	۵۳
جدول ۴-۴ . مقادیر قله جذب و گاف انرژی نمونه های ۲ و ۳	۵۷
جدول ۵-۴ . زاویه شیب و تماس قطره آب روی سطوح تولیدی	۶۸

فهرست شکل ها

	عنوان شکل
	صفحه
۷	شکل ۱-۱ . نمای شماتیکی از مرتب شدن دو قطبی های مغناطیسی لحظه ای در دمای اتاق
۹	شکل ۱-۲ . مغناطیس شدگی M به ازای میدان مغناطیسی H برای یک نمونه پارامغناطیس
۱۰	شکل ۳-۱ . ساختار کریستالی Co_3O_4
۱۲	شکل ۴-۱ . تصویر میکروسکوپی از برگ نیلوفر آبی
۱۴	شکل ۵-۱ . ترشوندگی سطوح جامد طبق رابطه یانگ
۱۵	شکل ۶-۱ . حالت های ترشوندگی (الف) و نزل (ب) کاسی-باکستر و (ج) مدل های ترکیب شده
۱۷	شکل ۷-۱ . زاویه تماس قطره روی سطوح مختلف
۲۰	شکل ۸-۱ . تصویر چوب فرآوری شده با اسپری نیلوفر آبی
۲۶	شکل ۱-۲ . شمای کلی روش سل - ژل
۲۹	شکل ۲-۲ . طرح شماتیکی از یک میکروسکوپ الکترونی عبوری
۳۰	شکل ۲-۳ . نمودار شماتیک اجزای اصلی یک میکروسکوپ الکترونی روبشی
۳۵	شکل ۴-۲ . طرح شماتیکی از مدل دمای اتاق VSM
۳۶	شکل ۵-۲ . طرح یک UV-Vis
۳۸	شکل ۶-۲ . ارتعاش های کششی متقارن و نامتقارن در یک مولکول
۳۸	شکل ۷-۲ . نمودار ساده یک طیف نور سنج مادون قرمز
۴۲	شکل ۳-۱ . طرح شماتیکی از وسایل استفاده شده در تهیه نانوذرات به روش سل - ژل
۴۳	شکل ۳-۲ . طرحی از عملیات تهیه نانوذرات کبالت اکسید به روش سل - ژل
۴۴	شکل ۳-۳ . طرحی از عملیات تهیه نانوذرات کبالت اکسید به روش واکنش حالت جامد

۴۵	شکل ۴-۳ . طرحی از عملیات تهیه لایه ابرآب‌گریز
۵۰	شکل ۴-۱ . طیف XRD نمونه شماره ۱
۵۱	شکل ۴-۲ . طیف XRD نمونه شماره ۲
۵۳	شکل ۴-۳ . طیف XRD نمونه شماره ۳
۵۵	شکل ۴-۴ . طیف UV – Vis نمونه شماره ۲
۵۵	شکل ۴-۵ . نمودار محاسبه انرژی گاف نمونه شماره ۲
۵۶	شکل ۴-۶ . طیف UV- Vis نمونه شماره ۳
۵۶	شکل ۴-۷ . نمودار محاسبه انرژی گاف نمونه شماره ۳
۵۸	شکل ۴-۸ . منحنی H – M نمونه شماره ۱ در دمای اتاق
۵۹	شکل ۴-۹ . منحنی H – M نمونه شماره ۲ در دمای اتاق
۵۹	شکل ۴-۱۰ . منحنی H – M نمونه شماره ۳ در دمای اتاق
۶۰	شکل ۴-۱۱ . طیف FT-IR نمونه شماره ۲
۶۱	شکل ۴-۱۲ . طیف FT-IR نمونه شماره ۳
۶۱	شکل ۴-۱۳ . تصویر TEM (A)نمونه شماره ۲ و (B) نمونه شماره ۳
۶۳	شکل ۴-۱۴ . تصویر SEM لایه A با بزرگنمایی ۳۰۰۰ برابر
۶۴	شکل ۴-۱۵ . تصویر SEM لایه B با بزرگنمایی ۳۰۰۰۰ برابر
۶۵	شکل ۴-۱۶ . تصویر SEM لایه A با بزرگنمایی ۳۰۰۰۰۰ برابر
۶۶	شکل ۴-۱۷ . تصویر SEM لایه B با بزرگنمایی ۳۰۰۰۰۰ برابر
۶۷	شکل ۴-۱۸ . تصاویری از سطوح ابرآب دوست و ابرآب گریز کبالت اکسید تولیدی
۶۹	شکل ۴-۱۹ . قطره آب روی سطح ابرآب گریز A با زاویه تماس میانگین $153/45^{\circ}$
۶۹	شکل ۴-۲۰ . قطره آب روی سطح ابرآب گریز B با زاویه تماس میانگین $152/55^{\circ}$

فهرست علائم

علامت نشانه

انرژی گاف E_g (eV)

میدان مغناطیسی H (Oe)

مغناطش M (emu/g)

دماي مطلق T (K)

فصل اول

مقدمه

۱-۱- نانوتکنولوژی چیست؟

پیشوند نانو در کلمه نانوتکنولوژی به معنی یک میلیاردم (10^{-9}) است. نانوتکنولوژی با ساختارهای مختلفی از مواد سروکار دارد که این ساختارها و ابزارهای سودمند با ابعاد نانومتر همواره وجود داشته‌اند و در حقیقت عمر چنین ساختارهایی به اندازه طول عمر زمین می‌باشد. به عنوان نمونه صدف مارپیچ که سطح داخلی آن کربنات کلسیم به شکل آجرهای نانوساختار است و به علت وجود این آجرها، ترکهای شکل گرفته در سطح خارجی صدف قادر به ادامه حرکت به درون پوسته نمی‌باشند^[۱]. اگر چه اصطلاح نانوتکنولوژی در ابتدا به وسیله پروفسور نورینو تانیگوچی^۱ از دانشگاه علوم توکیو در سال ۱۹۷۴ به کاربرده شد تا ساختار دقیق مواد با دامنه تغییرات نانومتر را توصیف کند، اما ایده آن از سال‌ها پیش مطرح بود و اغلب به پروفسور ریچارد فاینمن^۲ نسبت داده می‌شود. پروفسور فاینمن در سخنرانی سال ۱۹۵۹ تحت عنوان "فضاهای بسیاری در سطوح پایین وجود دارد" این ایده را مطرح کرد. اما اریک درکسلر^۳ به علت استفاده از عبارت نانو تکنولوژی در کتاب موتورهای آفرینش در سال ۱۹۸۶ اغلب به عنوان باز آفرین عبارت نانوتکنولوژی معرفی می‌شود. بسته به دیدگاه افراد، تعاریف مختلفی برای نانوتکنولوژی و نانو مواد وجود دارد اما یک تعریف کاربردی و پذیرفته شده عبارت است از: "طراحی، مشخصه یابی، تولید و کاربرد ساختارها، وسایل و سیستم‌ها به وسیله دستکاری کنترل شده اندازه و شکل در مقیاس نانومتر (مقیاس اتمی، مولکولی و ماکرومولکولی) به طوریکه بتوان ساختارها، وسایل و سیستم‌هایی با حداقل یک مشخصه یا خاصیت جدید و ممتاز را تولید کرد"^[۲].

بنا به تعریفی که در مورد نانو تکنولوژی مطرح شد می‌توان به اهمیت آن در کاربردهای مختلف صنعتی و تجاری پی برد. یکی از جنبه‌های کاربرد سیستم‌های نانو مقیاس از جمله نانوذرات استفاده از آن‌ها جهت تهییه سطوح خود تمیز شونده می‌باشد. در پایان نامه حاضر نیز تهییه سطوح ابرآب گریز که خاصیت خود تمیز شوندگی دارند مد نظر می‌باشد. جهت تهییه این سطوح، ابتدا نانوذرات کبالت اکسید به دو روش متفاوت تهییه شده و سپس پوشش ابرآب گریز آن‌ها تهییه می‌شود. در فصل اول، مروری بر نانو مواد، خواص آن‌ها و همچنین خواص نانوذرات کبالت اکسید مطرح می‌شود. در فصل دوم، روش‌های به کار رفته جهت سنتز نانوذرات و نیز دستگاههای مشخصه یابی آن‌ها تشریح می‌شوند. در فصل سوم، آزمایش‌های انجام‌شده جهت تهییه نانوذرات

¹ Norio Taniguchi

² Richard Feynman

³ Erick Derecseler

کجالت اکسید و تهیه سطوح ابرآب‌گریز بیان می‌شود. فصل چهارم به بیان نتایج و تحلیل یافته‌ها اختصاص دارد.

در انتهای در فصل پنجم، نتایج کلی و پیشنهاداتی جهت کارهای آینده مطرح می‌شود.

۱-۲-۱- مروری بر نانو مواد

برای تعریف نانومواد می‌توان از ابعاد هندسی جسم کمک گرفت. در صورتی که ماده مورد نظر در سه بعد در مقیاس نانو، (100 nm) قرار داشته باشد معمولاً از لفظ "نانو ذره" استفاده می‌شود. این ذرات به دلیل نسبت سطح به حجم بالا، فعالیت سطحی زیادی دارند و در پزشکی و داروسازی، داروپردازی، محافظت‌کننده‌ها، روان‌سازها، لوازم آرایشی و بهداشتی و کاتالیزورها مصرف می‌شوند. نانومیله‌ها و نانولوله‌ها مواد جامدی هستند که در دو بعد در مقیاس نانومتری می‌باشند. استفاده از پوشش‌های نانومتری (لایه‌های نانو متري) نیز مزایای فراوانی دارد. این مواد که فقط در یک بعد در مقیاس نانومتر هستند، مقاومت سایشی بسیار خوبی از خود نشان می‌دهند [۳].

۱-۲-۱- ساختار نانو ذرات

یکی از مهم‌ترین خواص نانوذرات نسبت سطح به حجم بسیار بالای آن‌هاست، یعنی اتم‌های موجود در سطح، کسر بالایی از اتم‌های تشکیل‌دهنده یک ذره را تشکیل می‌دهند. لذا این نسبت به همراه اندازه و شکل تقریباً یکنواخت، باعث خواص کاملاً متفاوت نانوذرات در مقایسه با ذرات درشت‌تر و مواد توده‌ای شده‌است. تشکیل تدریجی نانوذرات، در فازهای مایع یا جامد در طی سه مرحله جوانه‌زنی، ادغام و رشد اتفاق می‌افتد. وقتی غلظت جوانه ذرات در طی مراحل جوانه‌زنی به اندازه کافی زیاد شود، خوش‌های با هم ادغام می‌شوند. با بیشتر شدن غلظت، این خوش‌های به نحوی ادغام می‌شوند که خوش‌های بزرگ‌تر، رشد می‌کنند. بنابراین نانوذرات اغلب خوش‌های از اتم‌ها با ساختار فشرده مکعبی یا هگزاگونال می‌باشند. چنین ساختاری از یک اتم مرکزی که با لایه‌های مختلف اتمی احاطه شده است به وجود می‌آید.

عدد همسایگی اتم‌های سطحی در نانو ذرات، ۹ یا کمتر است که این تعداد متفاوت از عدد همسایگی ذرات بزرگ‌تر، که ۱۲ است، می‌باشد. چنانچه مشخص است با کاهش اندازه نانوذرات درصد اتم‌های سطح افزایش می‌یابد. قابل ذکر است که شکل هندسی ذرات نیز متاثر از پارامترهایی مانند ترکیب شیمیایی، خواص و روش تولید نانوذرات تعیین می‌شود [۴].

۱-۲-۲- خواص نانو ذرات

خواشنهای اتمی و ذرات نانومتری خواص متفاوتی از مواد حجمی را از خود نشان می‌دهند. علت این موضوع را می‌توان به اندازه آن‌ها نسبت داد. با کوچک شدن اندازه ذرات تعداد اتم‌های سطحی زیاد می‌شوند. در یک ذره با قطر حدود 4 nm حدود ۳۰٪ اتم‌ها در سطح قرار دارند. واضح است که انرژی اتم‌ها در سطح با انرژی آن‌ها در داخل مواد حجمی متفاوت است. بنابراین انتظار داریم خواص این ذرات به اندازه آن‌ها بستگی زیادی داشته باشد. هر چه ذرات کوچکتر می‌شوند این وابستگی نیز افزایش می‌یابد. خواص فیزیکی مواد را معمولاً می‌توان به طول‌های مشخصه‌ای مانند طول پویش آزاد میانگین اتم‌ها، طول نفوذ حرارتی و غیره نسبت داد. بنابراین خواص فیزیکی به مقدار قابل توجهی با کوچک شدن اندازه ذرات تحت تاثیر قرار می‌گیرند. بسیاری از ویژگی‌های شیمیایی مواد نیز به سطح آن‌ها بستگی دارد. برای مثال سرعت حل شدن یا نفوذ با سطح ذرات ارتباط مستقیم دارد. از آنجا که کسر زیادی از اتم‌های ذرات نانومتری در سطح قرار دارند این مواد بیشتر مشابه بخار یا گاز فعالیت می‌کنند تا مواد جامد. بنابراین رفتار جنبشی این ذرات بیشتر از قوانین نفوذ گازها پیروی می‌کند. سرعت حل شدن این ذرات در محلول‌ها نیز به مراتب زیادتر از ذرات میکرومتری یا حجمی گزارش شده است. از آن‌جا که اندازه گیری خواص مکانیکی این ذرات بسیار دشوار است گزارش‌های زیادی در اختیار نیست. با وجود این اخیراً توسط روش‌های میکروسکوپ الکترونی عبوری^۱ و میکروسکوپ تونلی روبشی^۲ فعالیت‌هایی برای تعیین استحکام و مدول کشسانی نانوذرات و نانولوله‌ها انجام شده است. این مطالعات نشان می‌دهند که ذرات چند نانومتری استحکام و مقاومت بیشتری تحت نیرو از خود نشان می‌دهند.

دمای ذوب نانو ذرات فلزی به اندازه آن‌ها بستگی دارد به طوریکه با کاهش اندازه ذرات دمای ذوب کاهش می‌یابد. علت این پدیده را می‌توان به انرژی سطحی ذرات نسبت داد [۳]. در ادامه خواص نوری و مغناطیسی نانو ذرات به طور مفصل تر بررسی می‌شود.

۱-۲-۲-۱- خواص نوری

خواص نوری نانو ذرات بیشتر در مورد مواد نیمه هادی مطرح است. در این مواد، خواص اپتیکی با اندازه

¹ Transmission electron microscopy

² Scanning tunneling microscopy

ذرات ارتباط مستقیمی دارد به طوری که شدت طیف اپتیکی نانوذرات نیمه هادی با تغییر اندازه آن ها تغییر می کند. شدت پیک لبه جذب با کاهش اندازه ذرات بزرگتر می شود در حالی که انتقالی نیز به انرژی های بالاتر صورت می گیرد. علت این تغییر را باید در ساختار الکترونیکی نیمه هادی جستجو کرد. می دانیم که بین نوارهای هدایت و ظرفیت در مواد فاصله انرژی وجود دارد که به گاف انرژی^۱ موسوم است. در مواد عایق، نوار ظرفیت از الکترون ها پر و گاف انرژی نیز زیاد است. تحت این شرایط امکان انتقال الکترون ها از نوار ظرفیت به نوار هدایت وجود ندارد و جسم عایق الکتریسیته است.

بر خلاف آن در مواد هادی مانند فلزات، نوارهای هدایت و ظرفیت هم پوشانی دارند و بنابراین انتقال الکترون ها به سادگی انجام می شود. در نیمه هادی ها گاف انرژی وجود دارد ولی مقدار آن زیاد نیست (در حدود 1 eV و کمتر از آن) [۳]. بنابراین انرژی حرارتی حتی در دمای اتاق می تواند قسمتی از الکترون ها را به نوار هدایت منتقل کند و هدایت الکتریکی خفیفی حاصل شود. اگر فوتون هایی به یک نیمه هادی تابیده شود که انرژی آن بزرگتر از گاف انرژی باشد، الکترون ها به نوار هدایت منتقل می شوند و حفره هایی در نوار ظرفیت شکل می گیرند. به دلیل نیروی کولنی بین الکترون های منفی و حفره ها (بار مثبت) یک جفت الکترون - حفره مقید به نام اکسیتون ایجاد می شود. حضور چنین جفت الکترون - حفره ای به مقدار قابل توجهی بر خواص نوری نیمه هادی اثر می گذارد. در نانوذرات فاصله بین الکترون و حفره توسط اندازه ذرات کنترل می شود به طوریکه با ریز شدن اندازه ذرات تا مقیاس نانومتر حرکت اکسیتون ها محدود و انتقالی در طیف نوری مشاهده می شود. از آن جا که این انتقال به سمت سطوح انرژی بیشتر (طول موج کمتر) است، به این پدیده جایی آنی گفته می شود. در صورتی که اندازه نانوذرات بسیار کوچک شود ممکن است سطح انرژی جفت الکترون - حفره تغییر کند. در این شرایط یک انتقال در طیف نوری دیده می شود ولی طیف های جدید نیز مشاهده خواهد شد. چنانچه در بالا ذکر شد انتقال طیف نوری به انرژی های بالاتر در اثر کاهش اندازه ذرات به معنی افزایش گاف انرژی است. هم چنین باید توجه داشت که افزایش شدت طیف نوری در اندازه های کوچکتر ذرات به حضور اکسیتون ها در نیمه هادی و فاصله کمتر آن ها نسبت به ذرات درشت بر می گردد [۳].

¹ Band gap

۱-۲-۲-۲- خواص مغناطیسی

تحقیقات نشان داده که کاهش در اندازه ذرات منجر به تغییر در خواص مغناطیسی می شود. اندازه ذرات مورد بحث ما، معمولاً کمتر از اندازه حوزه های مغناطیسی در جامدات است. بنابراین یک ذره مثل یک اتم مجزا رفتار می کند که گشتاور مغناطیسی بزرگی دارد. کاهش در اندازه دانه منجر به کاهش در انرژی ناهمسانگردی^۱ می شود. بنابراین گشتاور مغناطیسی می تواند با انرژی حرارتی کمتری از یک جهت به جهت دیگر تغییر کند [۵].

در دماهای بالاتر از یک دمای مشخص، که دمای قفل شدن^۲ نامیده می شود، انرژی حرارتی کافی برای ماده وجود دارد تا مثل یک اتم پارامغناطیس با گشتاور مغناطیسی بزرگ رفتار کند. این رفتار سوپر پارامغناطیس^۳ نامیده می شود و برای ذرات کوچک قابل ملاحظه است [۶].

مطابق مدل اتمی بور، اتم های یک ماده از هسته و الکترون هایی تشکیل شده اند که الکترون ها در مدارهای مشخص دور هسته می چرخند. به علاوه خود الکترون ها را می توان به عنوان ذرات باردار کروی در نظر گرفت که حول محور خود دوران می کنند. مجموعه حرکت دورانی الکترون دور هسته و حول محور خود میدان مغناطیسی ایجاد می کند. مواد مغناطیسی به شش دسته تقسیم می شوند که در جدول ۱-۱ به خواص آنها

شاره شده است این شش دسته عبارتند از :

۱. دیامغناطیس^۴

۲. پارامغناطیس^۵

۳. فرومغناطیس^۶

۴. آنتی فرومغناطیس^۷

۵. فری مغناطیس^۸

۶. سوپرپارامغناطیس^۹

^۱ Anisotropic Energy

^۲ Blocking Temperature

^۳ Super Paramagnetic

^۴ Diamagnetic

^۵ Paramagnetic

^۶ Ferromagnetic

^۷ Antiferromagnetic

^۸ Ferromagnetic

^۹ Superparamagnetic

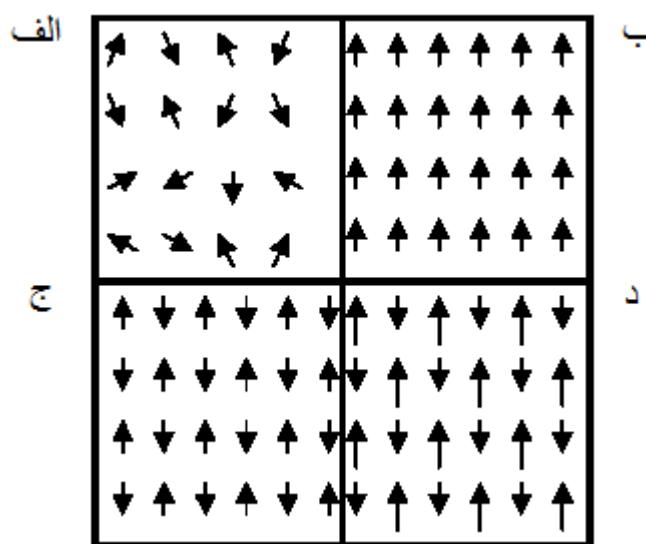
خواص مغناطیسی یک ماده ناشی از ساختار الکترونیکی اتم‌ها در ماده است. مواد مغناطیسی متفاوتند، برخی مغناطیس خیلی ضعیف (دیامغناطیس) و بعضی مغناطیس دائمی^۱ (فرومغناطیس) هستند. مهمترین خاصیت خاصیت مغناطیسی هر ماده نفوذپذیری مغناطیسی آن χ است:

$$\chi = \frac{M}{H} \quad (1-1)$$

که در آن M مغناطیس شدگی و H شدت میدان مغناطیسی است. نفوذپذیری مغناطیسی برای هر ماده متفاوت است و به صورت زیر به دمابستگی دارد (البته به جز مواد دیامغناطیس):

$$\chi = \frac{c}{T + \theta} \quad (2-1)$$

که c, θ ثابت‌هایی هستند که برای هر ماده متفاوت است و T دمای مطلق است [۷]. شکل ۱-۱ ، طریقه مرتب شدن دوقطبی‌های مغناطیسی را برای هر دسته از مواد نشان می‌دهد.



شکل ۱-۱ . نمای شماتیکی از مرتب شدن دوقطبی‌های مغناطیس لحظه‌ای در دمای اتاق :

(الف) مواد پارامغناطیس یا سوپرپارامغناطیس (ب) مواد فرمغناطیس (ج) مواد آنتی فرمغناطیس و

(د) مواد فری مغناطیس [۹].

^۱ Permanently